性能特点：

- RF/LO 频段：7GHz~ 25GHz
- IF 频段：DC ~ 6GHz
- 变频损耗：7.5dB
- RF-IF 隔离度：13dB
- LO-IF 隔离度：38dB
- LO-RF 隔离度：35dB
- 本振功率：13dBm
- 芯片尺寸：1.34mm×1.18m×0.10mm

产品简介：

NC17111C-725/NC17111C-725 M 是一种 GaAs MMIC 无源双平衡混频器，芯片射频/本振频率覆盖 7 ~25GHz，中频频率覆盖 DC ~ 6GHz，变频损耗小于 10.5dB，射频到中频隔离度大于 9dB，本振到中频隔离度大于 32B，本振到射频隔离度大于 23dB，典型本振输入功率 13dBm。芯片采用 GaAs 肖特基二极管工艺制造。

电参数：（T_A =+25℃，IF=0.1GHz，LO=+13dBm）

指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率	7 ~ 25			GHz
本振频率	7 ~25			GHz
中频频率	DC ~ 6			GHz
变频损耗	7	7.5	10.5	dB
LO-RF 隔离度	33	38	42	dB
LO-IF 隔离度	23	35	40	dB
RF-IF 隔离度	9	13	35	dB
射频输入 1dB 压缩点		12		dBm

注：除特殊标注，以上参数均为下变频模式测得，中频频率 0.1GHz，本振功率+13dBm。

注：对于兴趣频点的交调指标可以与我公司联系。

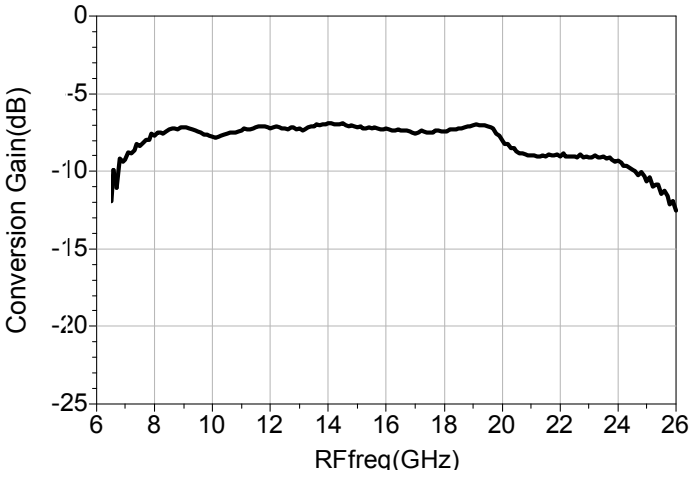
使用限制参数：

射频最大输入功率	24	dBm
本振最大输入功率	24	dBm
建议本振功率范围	+10 ~ +20	dBm
存储温度	-65 ~ +150	℃
使用温度	-55 ~ +125	℃

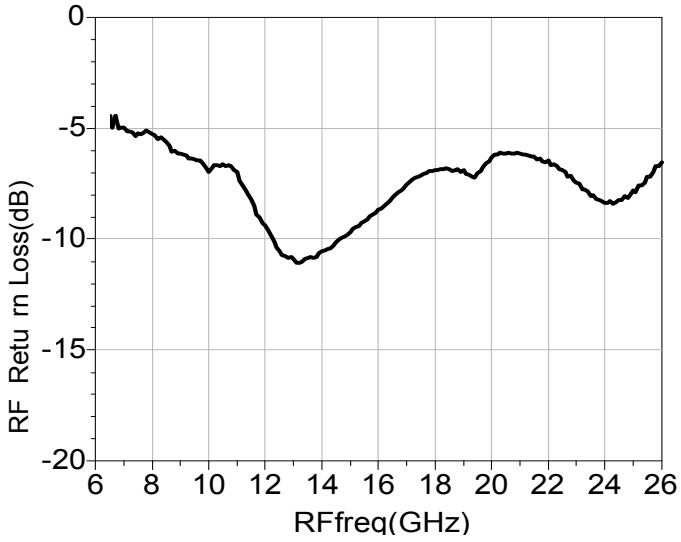
注：在建议本振功率范围内，混频器变频损耗随本振功率增加而减小，随本振功率减小而增加。

典型曲线：

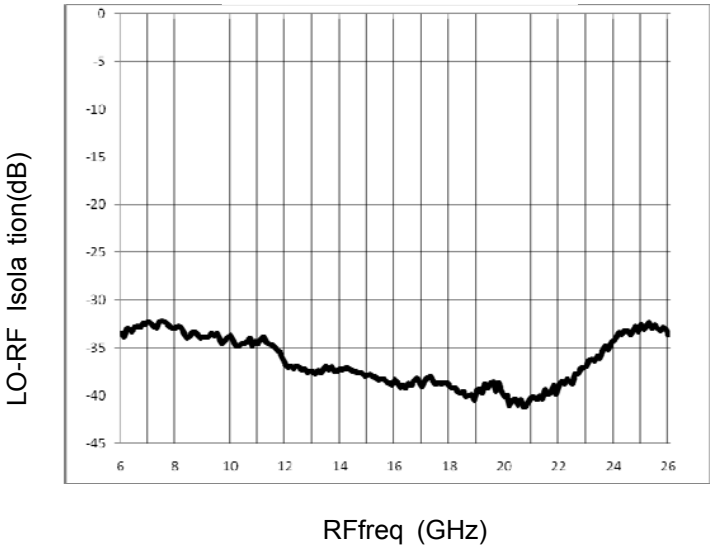
变频损耗 vs.射频频率



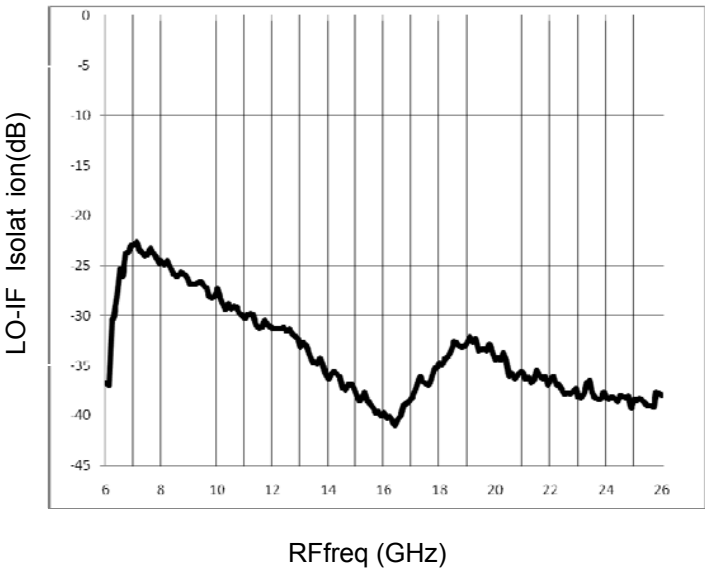
射频端回波损耗 vs.射频频率



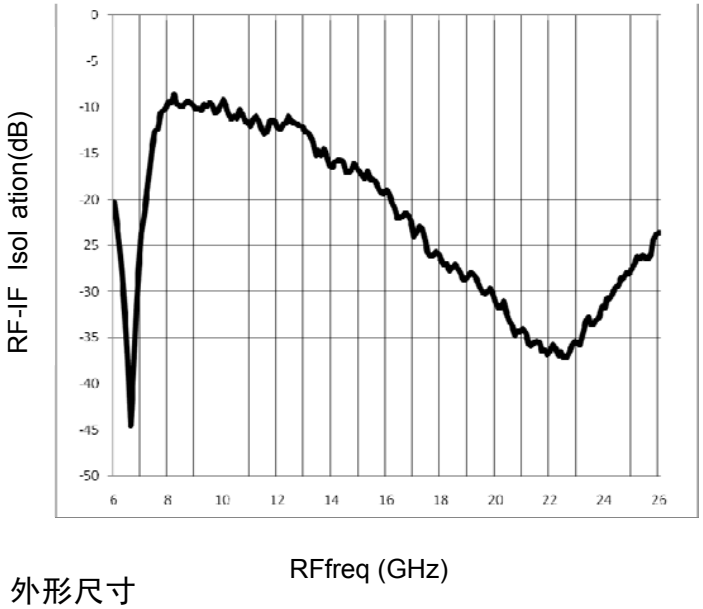
LO-RF 隔离度 vs.频率



LO-IF 隔离度 vs.频率



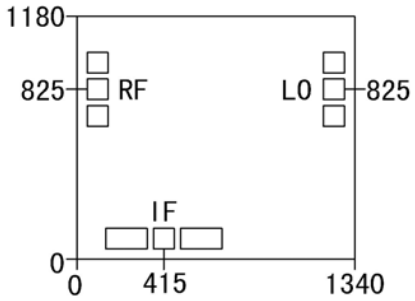
RF-IF 隔离度 vs.频率



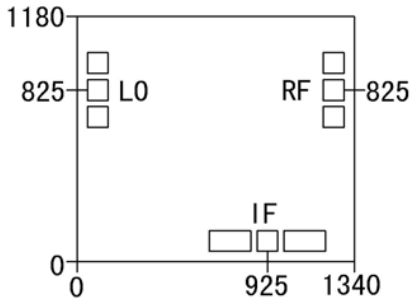
外形尺寸

NC17111C-725(M)外形尺寸

NC17111C-725



NC17111C-725M

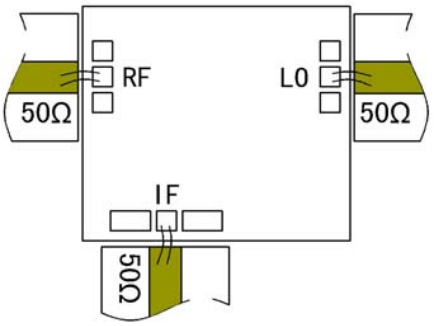


说明：所有尺寸单位为微米(μm)；

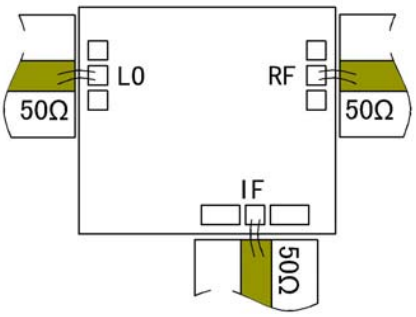
输入输出压点尺寸为 100×100μm^2。

建议装配图：

NC17111C-725



NC17111C-725M



注意事项：

1) 在净化环境装配使用。
2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心。
3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25μm 金丝），键合线尽量短，不要长于 500μm。
4) 输入输出无隔直电容。
5) 用 80/20 金锡烧结，烧结温度不要超过 300℃，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒。
6) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。
7) 干燥、氮气环境储存。
8) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。
9) 有问题请与供货商联系。

www.dianzibuy.com